3A12

(DMEDO-TTF)₂PF₆の構造と物性

(東工大院理工)〇白旗崇・川本正・白鳥啓太・大澤辰彦・森健彦

【序】エチレンジオキシ基を有するドナー分子(図 1)は有機溶媒に対する溶解性の高さや CH…O 型 水素結合の形成など優れた性質を有する。最近、エチレンジオキシ基を有するテトラセレナフルバレ ン(TSeF)誘導体 DMEDO-TSeF を成分とする擬一次元金属(DMEDO-TSeF)₂X (X = PF₆, AsF₆, SbF₆)や、常圧有機超伝導体 κ-(DMEDO-TSeF)₂[Au(CN)₄](Solvent) (Solvent = cyclic ether)が報告 されている。^[1] 一方、テトラチアフルバレン(TTF)誘導体 EDO-TTF の PF₆塩において巨大な光誘起 相転移が報告されており、酸素原子を有するドナー分子が注目されている。^[2]しかしながら酸素原 子を有するドナー分子の合成は難易度が高く、詳細な物性研究がなされていないケースが多い。表 題物質である(DMEDO-TTF)2PF6は130 K付近で一次の構造相転移を示すことが Fabre らによって 報告されているが、室温の構造、転移後の構造、伝導挙動の詳細は明らかにされていない。[3] 本研 究ではこの物質の 130 K における相転移を調べる目的で結晶構造と伝導挙動を調べ、室温の構造 が(DMEDO-TSeF), PF。類似の構造であり、130 Kの転移 が一次の金属-金属転移であることを明らかにした。さら CH₂ に、50 K において金属-絶縁体転移を示すことを明らか EDO-TTF DMEDO-TSeF (X = Se)にしたのでこの転移についても報告する。 図1 エチレンジオキシ基を有するドナー分子

【実験】DMEDO-TTF の合成は文献[3a]の方法で行った。(DMEDO-TTF)₂PF₆ の単結晶は DMEDO-TTF と TBA·PF₆をクロロベンゼン、THF またはエタノール中で電気分解することにより作製 した。いずれの場合も黒色の針状晶が得られるが、クロロベンゼン中で作製した結晶の質がもっとも 良いため、この結晶を用いて結晶構造解析と電気伝導度・磁化率の測定を行った。

【結果と考察】(DMEDO-TTF)₂PF₆の室温および150 K における結晶パラメータを表1に示す。この塩の構造は(DMEDO-TSeF)₂PF₆^[2a] とほぼ同型であり、(TMTSF)₂X^[4] 類似の構造である(図2a)。ドナー分子は head-to-tail で a 軸方向に積層し、ab 面に伝導シートを形成している(図2b)。ドナー分子末端のエチレン炭素は室温ではディスオーダーしているが、150 K ではオーダーしている。一方、PF₆アニオンのリン原子は格子点に存在し、フッ素原子は室温からすでにオーダーしている。室温で PF₆アニオンのフッ素原子がディスオーダーしている(DMEDO-TSeF)₂PF₆と比較してこの点が異なってい

表1	(DMEDO-TTF)	pPF6の結晶パラメータ
----	-------------	--------------

T/K	293	150	
Crystal system	triclinic	triclinic	
Space group	P1 (#2)	P1 (#2)	
a / Å	7.117(1)	6.9526(8)	
<i>b</i> / Å	7.657(2)	7.612(1)	
<i>c</i> / Å	13.517(3)	13.445(2)	
lpha / °	74.82(2)	74.56(1)	
eta / °	80.55(2)	80.66(1)	
y/°	77.77(2)	81.18(1)	
$V/\text{\AA}^3$	690.1(2)	672.2(2)	
$R_1; R_w^{\mathrm{a})}$	0.0637; 0.1800	0.0530; 0.1557	
a) $R_1 = \Sigma Fo - F_c / \Sigma F_o ; R_w = [\Sigma w (F_o^2 - F_c^2)^2 / \Sigma w (F_o^2)^2]^{1/2}.$			

図2 (DMEDO-TTF)₂PF₆の結晶構造(293K). (a) *a* 軸投影図; (b) ドナー分子配列.

る。転移後の構造を調べる目的で 150 K 以下の構 造解析も試みたが、転移点で結晶が崩壊するため 低温相の構造は明らかにできていない。室温の結晶 構造解析に基づいて強結合近似法により計算したこ の物質のバンド構造とフェルミ面から(図3)、この物 質が積層方向に一次元的な電子系を有することが 明らかになった。



図3 (DMEDO-TTF)₂PF₆のバンド構造およびフェ らかになった。 図4に伝導シートに平行および垂直方向に測定し a2 = 25.96, b = -0.05, pl = 4.21, p2 = 1.38.

た比抵抗の温度依存性を示す。伝導シートに対し平行に測定した場合室温から金属的な挙動を示 すが、伝導シートに対し垂直に測定した場合半導体的な振る舞いを示す。同様の現象は (TMTSF)₂PF₆で報告されており、^[5]この物質がバンド計算の結果通り強い一次元性を有することを 示している。いずれの方向でも約130 Kで抵抗の飛びを伴った急激な転移がみられ、転移温度以下 でも金属的挙動は保持されるが、約50 Kで金属-絶縁体転移を示す。130 K付近の転移は温度履 歴(130-195 K)があり、また冷却速度に依存した過冷却がみられることから一次の金属-金属転移で あると考えられる。130 K付近の転移およびこの物質の基底状態を調べるため無配向試料について SQUID による磁化率の測定を行った(図5)。室温の磁化率は3.6×10⁻⁴ emu mol⁻¹であり、一般的な 一次元系有機導体のパウリ常磁性として妥当な値である。磁化率は温度の低下に伴い徐々に減少 するが、142 Kから上昇し130 Kで極大になりその後パウリ常磁性的な振る舞いを示す。抵抗測定と 同じように磁化率でも温度履歴が観測され温度範囲(130-195 K)もよく一致している。一方、金属-絶縁体転移温度 50 K では磁化率の減少がみられ、この物質の基底状態は非磁性の絶縁相である ことが明らかになった。当日は ESR の結果についても報告する。



図4 (DMEDO-TTF)₂PF₆の比抵抗の温度依存性.



図5 (DMEDO-TTF)₂PF₆の磁化率の温度依存性.

【謝辞】SQUIDによる磁化率測定を行うにあたりお世話になりました東京工業大学大学院理工学研究科の 高井和之博士、榎敏明教授に感謝申し上げます。

【参考文献】

- [1] a) Shirahata, T. et al. J. Mater. Chem. 2005, 15, 4399; b) Shirahata, T. et al. Chem. Commun. 2006, 1592;
 c) Shirahata, T. et al. Chem. Eur. J. 2007, 13, 7619.
- [2] a) Chollet, M. et al. Science 2005, 307, 86; b) Ota, A. et al. J. Mater. Chem. 2002, 12, 2600.
- [3] a) Fabre, J. M. et al. Synth. Met. 1993, 60, 295; b) Fabre, J. M. et al. Synth. Met. 1995, 70, 1127.
- [4] Bechgaard, K. et al. Solid State Commun. 1980, 33, 1119.
- [5] Moser, J. et al. Eur. Phys. J. B. 1998, 1, 39.